

ST02D-170F2

170V 200W

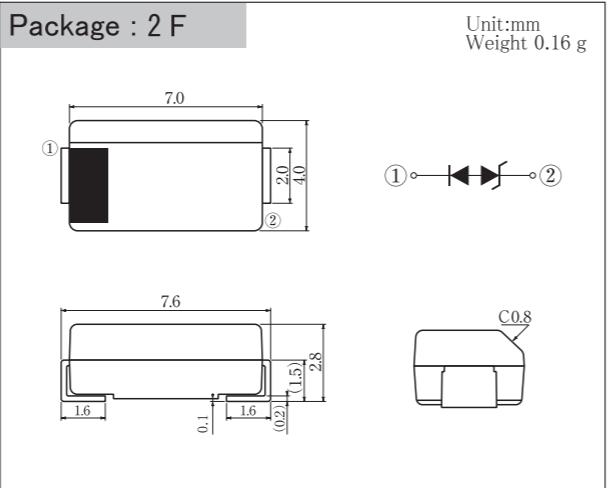
特長

- ・パワーゼネラーダイオードとFRDを複合
- ・面実装
- ・スナバ回路用途

Feature

- ・Power Zener Diodes with FRD
- ・SMD Package
- ・Application for snubber circuit

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T₁=25°C / unless otherwise specified)

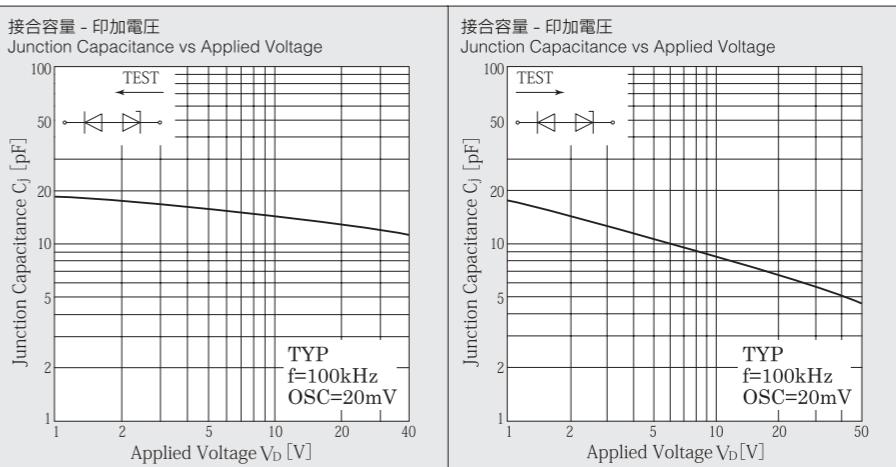
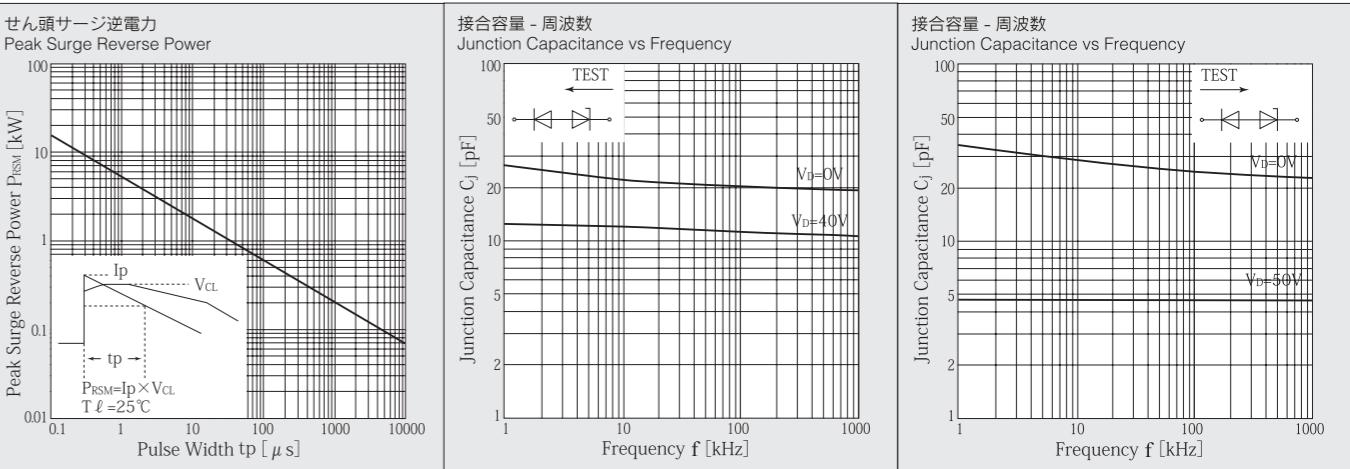
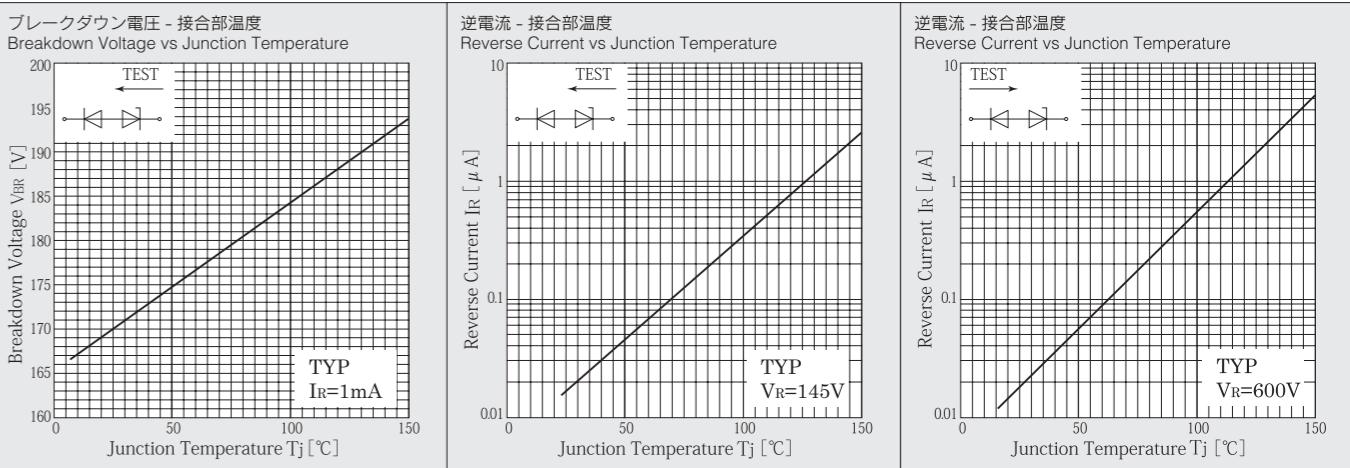
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	ZD	Di	単位 Unit
保存温度 Storage temperature	T _{stg}		-40~150	-40~150	°C
接合部温度 operating junction temperature	T _j		150	150	°C
せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power	PRSM	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	200	-	W
せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current	I _{RSRM}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	0.75	-	A
連続印加電圧 Maximum reverse voltage	V _{RM}		145	600	V

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T₁=25°C / unless otherwise specified)

動作開始電圧 Breakdown voltage	V _{BR}	I _R =1mA	MIN. 155 TYP. 170 MAX. 185	-	V
制限電圧 Restriction voltage	V _{CL}	I _{pp} =0.75A	MAX. 280	-	V
逆電流 Reverse current	IR	V _R =145V	MAX. 5	-	μA
		V _R =600V	-	MAX. 5	
逆回復時間 Reverse recovery time	t _{rr}	I _F / I _R = 0.1A / 0.3A	-	MAX. 500	ns
熱抵抗 Thermal resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 junction to lead	MAX. 24	°C/W	
	θ _{ja}	接合部・周囲間 プリント基板実装 junction to ambient On glass-epoxy substrate	MAX. 120		
		接合部・周囲間 アルミナ基板実装 junction to ambient On alumina substrate	MAX. 90		

2F Package

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



*Sine waveは50Hzで測定しています。
*50Hz sine wave is used for measurements.
*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
*Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical a statistical average of the devices ability.